

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 19480—89
(СТ СЭВ 1817—88, СТ СЭВ 4755—84,
СТ СЭВ 4756—84)

Издание официальное

1 р. 10 коп. БЗ 12—89/1048

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

ГОСТ

Термины, определения и буквенные обозначения
электрических параметров

19480—89

Integrated circuits Terms, definitions
and letter symbols of electrical parameters(СТ СЭВ 1817—88,
СТ СЭВ 4755—84,
СТ СЭВ 4756—84)

ОКСТУ 6301

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и буквенные обозначения электрических параметров интегральных микросхем.

Термины и буквенные обозначения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Международные буквенные обозначения обязательны для применения в технической документации, предназначенной для экспортных поставок.

1. Стандартизованные термины с определениями и буквенные обозначения приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1990

2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

2.4. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском (Е) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—4.

4. Методика образования буквенных обозначений производных параметров приведена в приложении.

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Таблица 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Параметр интегральной микросхемы Параметр	X	X	Величина, характеризующая свойства или режимы работы интегральной микросхемы
2. Номинальное значение параметра интегральной микросхемы Номинальное значение параметра	$X_{ном}$	$X_{ном}$	Значение параметра интегральной микросхемы, заданное в нормативно-технической документации и являющееся исходным для отсчета отклонений
3. Диапазон значений параметра интегральной микросхемы Диапазон значений параметра	δX	—	Область, в которую укладываются значения параметров всех интегральных микросхем данного типа или партии однотипных интегральных микросхем при заданном уровне доверительной вероятности
4. Допустимый диапазон значений параметра интегральной микросхемы Допустимый диапазон значений параметра	$\delta X_{дп}$	—	Разброс значений параметра интегральной микросхемы, указанной в нормативно-технической документации
5. Отклонение параметра интегральной микросхемы Отклонение параметра	ΔX	—	Разность между действительным значением параметра интегральной микросхемы и его номинальным значением

Продолжение табл. 1

Термин	Буквенное обозначение		Определение
	отечественное	международное	
6. Относительное отклонение параметра интегральной микросхемы Относительное отклонение параметра	$\Delta X_{\text{отн}}$	—	Отношение отклонения параметра интегральной микросхемы к его номинальному значению
7. Напряжение (ток) управления интегральной микросхемы Напряжение (ток) управления	$X_{\text{упр}}$	—	Напряжение (ток) управляющее функциональным назначением интегральной микросхемы
8. Температурный коэффициент параметра интегральной микросхемы Температурный коэффициент параметра	α_x	α_x	Отношение изменения параметра интегральной микросхемы к вызвавшему его изменению температуры окружающей среды
9. Нестабильность параметра интегральной микросхемы Нестабильность параметра	$\Delta X_{\text{нст}}$	—	Отношение относительно-го отклонения параметра интегральной микросхемы к вызвавшему его дестабилизирующему фактору
10. Максимальное значение параметра интегральной микросхемы Максимальное значение параметра	X_{max}	X_{max}	Наибольшее значение параметра интегральной микросхемы, при котором заданные параметры соответствуют заданным значениям
11. Минимальное значение параметра интегральной микросхемы Минимальное значение параметра	X_{min}	X_{min}	Наименьшее значение параметра интегральной микросхемы, при котором заданные параметры соответствуют заданным значениям

ПАРАМЕТРЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

12. Напряжение питания интегральной микросхемы Напряжение питания	$U_{\text{п}}$	$U_{\text{сс}}$	Значение напряжения на выводах питания интегральной микросхемы
13. Входное напряжение интегральной микросхемы Входное напряжение	$U_{\text{вх}}$	U_{I}	Напряжение на входе интегральной микросхемы в заданном режиме
14. Выходное напряжение интегральной микросхемы Выходное напряжение	$U_{\text{вых}}$	U_{O}	Напряжение на выходе интегральной микросхемы в заданном режиме